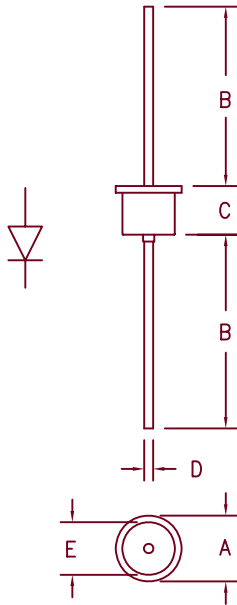


5 Amp Schottky Rectifier

1N5823, 1N5824, 1N5825



| Dim. | Inches | | Millimeter | | Notes |
|------|---------|---------|------------|---------|-------|
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| A | --- | .450 | --- | 11.43 | Dia. |
| B | .980 | --- | 24.89 | --- | |
| C | --- | .300 | --- | 7.62 | |
| D | .046 | .056 | 1.17 | 1.42 | Dia. |
| E | --- | .350 | --- | 8.89 | Dia. |

| Microsemi Catalog Number | Working Peak Reverse Voltage | Repetitive Peak Reverse Voltage |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1N5823 | 20V | 20V |
| 1N5824 | 30V | 30V |
| 1N5825 | 40V | 40V |

- Schottky Barrier Rectifier
- 125°C Junction temperature
- V_{RRM} 20 to 40 Volts
- 5 Amp current rating
- Very low forward voltage
- JAN, JANTX, JANTXV & JANS equivalent screening available

| Electrical Characteristics | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--|
| | | 1N5823 | 1N5824 | 1N5825 | |
| Average forward current | $I_F(AV)$ | 5.0A | 5.0A | 5.0A | $T_L = 85^\circ C$, square wave, $R_{\theta JL} = 12^\circ C/W$ |
| Maximum surge current | I_{FSM} | 500A | 500A | 500A | 8.3ms, half sine, $T_J = 125^\circ C$ |
| Max peak forward voltage | V_{FM} | .330V | .340V | .350V | $I_{FM} = 3.0A; T_J = 25^\circ C^*$ |
| Max peak forward voltage | V_{FM} | .360V | .370V | .380V | $I_{FM} = 5.0A; T_J = 25^\circ C^*$ |
| Max peak forward voltage | V_{FM} | .470V | .490V | .520V | $I_{FM} = 15.7A; T_J = 25^\circ C^*$ |
| Max peak reverse current | I_{RM} | 10mA | 10mA | 10mA | $V_{RRM}, T_J = 25^\circ C$ |
| Max peak reverse current | I_{RM} | 100mA | 125mA | 150mA | $V_{RRM}, T_J = 100^\circ C$ |
| Typical junction capacitance | C_J | 1470pF | 1470pF | 1470pF | $V_R = 5.0V, T_J = 25^\circ C$ |

*Pulse test: Pulse width 300 μ sec, Duty cycle 2%

| Thermal and Mechanical Characteristics | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| Storage temperature range | T_{STG} | -65°C to 125°C |
| Operating junction temp range | T_J | -65°C to 125°C |
| Maximum thermal resistance | $L = 1/4"$ $R_{\theta JL}$ | 12°C/W Junction to lead |
| Weight | | .08 ounces (2.4 grams) typical |



6 Lake Street
Lawrence, MA 01841
PH: (978) 620-2600
FAX: (978) 689-0803
www.microsemi.com

05-09-07 Rev. 2

1N5823, 1N5824, 1N5825

Figure 1
Typical Forward Characteristics

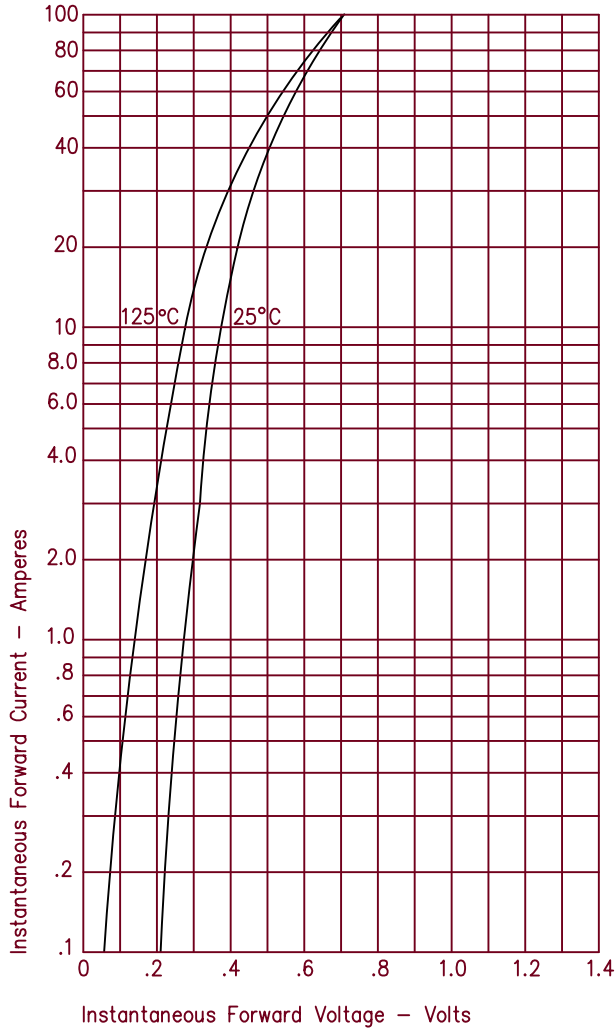


Figure 3
Typical Junction Capacitance

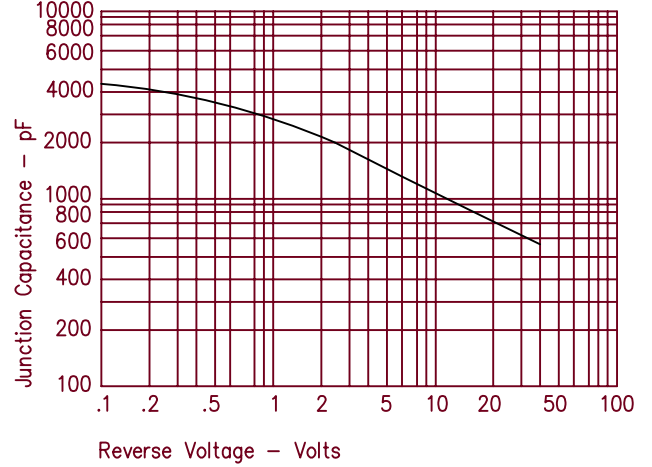
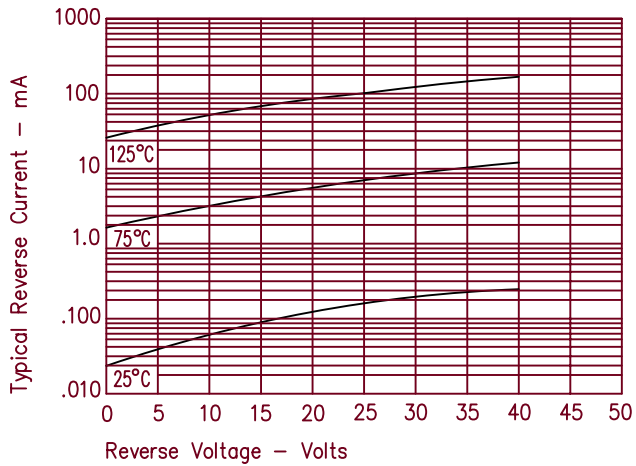


Figure 2
Typical Reverse Characteristics



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9